(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年2月17日(17.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/015964 A1

(51) 国際特許分類7: H05H 1/46, H01L 21/205, 21/3065, 21/30, C23C 16/505 PCT/JP2004/011162

(21) 国際出願番号:

(22) 国際出願日: 2004年8月4日 (04.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-289223 2003 年8 月7 日 (07.08.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目 14番20号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹田 智彦

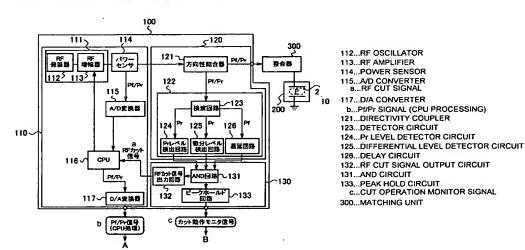
(TAKEDA, Tomohiko) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中 野区東中野3丁目14番20号株式会社日立国 際電気内 Tokyo (JP). 杉原 賢 (SUGIHARA, Ken) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番 20号 株式会社日立国際電気内 Tokyo (JP). 浜野 勝 艶 (HAMANO, Katsuyoshi) [JP/JP]; 〒1648511 東京都 中野区東中野3丁目14番20号株式会社日立国 際電気内 Tokyo (JP). 吉野 晃生 (YOSHINO, Teruo) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番 20号 株式会社日立国際電気内 Tokyo (JP). 石丸 信 雄 (ISHIMARU, Nobuo) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中 野区東中野3丁目14番20号 株式会社日立国際 電気内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 油井 透, 外(YUI, Tohru et al.); 〒1020072 東 京都千代田区飯田橋 4 丁目 6番 1号 2 1 東和ビル 3 階 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS AND SUBSTRATE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置及び基板処理方法



(57) Abstract: Occurrence of microarcs is detected so as to effectively suppress the microarcs that would otherwise cause damage to (57) Abstract: Occurrence of microarcs is detected so as to effectively suppress the microarcs that would otherwise cause damage to devices and substrates. A substrate processing apparatus is adapted to apply a high frequency electric power from a high frequency power supply part (100) through a matching unit (300) to an electrode (210) provided in a processing room (200) to generate a plasma (P). A directivity coupler (121) is provided between a high frequency power supply source (111) and the matching unit (300) to couple both a reflective wave reflected from the electrode (210) and a progressive wave progressing to the electrode (210) to a detector (122). The detector (122) outputs a detection signal when the level of the reflective wave (Pr) and its differential level exceed northeir respective prescribed values. In order for the beginning stage of discharging to be outside the detection interval, the detector (122) also outputs a delayed progressive wave obtained by delaying the progressive wave. Upon coincidence of three detection signals outputted from the detector (122), control means (130) regards it as occurrence of deleterious microarcs, and then applies an RF cut signal to a CPU (116), thereby temporally stopping or temporally reducing the high frequency electric power from the high frequency power supply source (111).

3

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

⁽⁵⁷⁾ 要約: マイクロアークの発生を検出して、装置や基板にダメージを与えるマイクロアークを有効に抑制する。 基板処理装置は、高周波電源部100から整合器300を介して処理室200に設けた電極210に高周波電力を印加して、プラズマPを発生するように構成される。高周波電源111と整合器300との間に方向性結合器121を設けて、電極210から反射する反射波、及び電極210に向かう進行波を検出器122に結合する。検出器122は反射波Prのレベル及びその微分レベルが各設定値を越えた時、検出信号を出力する。放電初期を検出期間から外すために、進行波を遅延させた遅延進行波も出力する。制御手段130は、検出器122から出力される3つの検出信号の一致がとれたとき、有害なマイクロアークが発生したとみなし、RFカット信号をCPU116に加え、高周波電源111からの高周波電力を一時停止又は一時低下する。